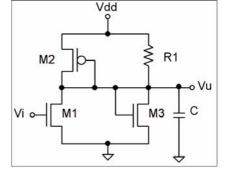
PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI ELETTRONICA A 18 LUGLIO 2006

1) Nel circuito in figura, il transistore bipolare può essere descritto da un modello "a soglia" con V_γ =0.75 V e $V_{CE,sat}$ =0.2 V, mentre il transistore MOS è caratterizzato dalla tensione di soglia V_{Tn} e dal coefficiente β_n . Si determini il margine d'immunità ai disturbi N_M della rete.

$$V_{cc}$$
 = 5 V, V_{Tn} = 0.5 V, β_n = 5 mA/V², β_F =100 , R_1 = 500 $\Omega,~R_2$ = 2 k $\Omega,~R_3$ = 500 $\Omega.$

2) Nel circuito in figura, i transistori MOS sono caratterizzati dalle tensioni di soglia $V_{Tn1}=|V_{Tp2}|=V_{Tn3}=V_{T}$ e dai coefficienti β_{n1} , β_{p2} , β_{n3} . Il segnale d'ingresso abbia il seguente andamento:

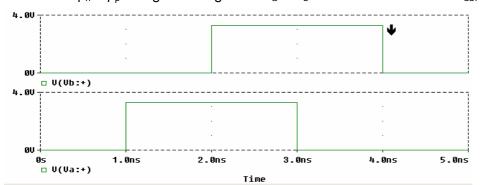
t<0: $V_i=0$ t>0: $V_i=Vdd$

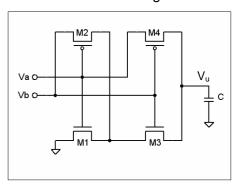


Si calcoli il tempo di propagazione $t_{\text{p,HL}}$ relativo al segnale di uscita V_{u} .

$$V_{dd} = 3.5 \text{ V}, V_{T} = 0.5 \text{ V}, \beta_{n1} = 5 \text{ mA/V}^2, \beta_{n2} = 1 \text{ mA/V}^2, \beta_{n3} = 0.2 \text{ mA/V}^2, R_1 = 5 \text{ k}\Omega, C = 10 \text{ pF}.$$

3) Nel circuito in figura, i transistori MOS sono caratterizzati dalla tensione di soglia $V_{Tn}=-V_{Tp}=V_{T}$ e dai coefficienti β_n e β_p . I segnali di ingresso V_a e V_b assumono i valori 0 e V_{dd} , secondo l'andamento seguente:



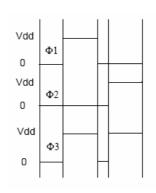


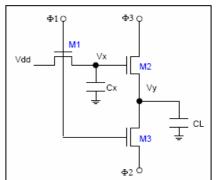
Si determini l'andamento qualitativo del segnale di uscita V_u e si calcoli il tempo di propagazione relativo alla transizione di V_b evidenziata (t=4 ns).

$$V_T = 0.45 \text{ V}, V_{dd} = 3.3 \text{ V}, \quad \beta_n = \beta_p = 1 \text{ mA/V}^2, C = 50 \text{ fF}.$$

4) Nel circuito in figura, i transistori MOS sono caratterizzati dalla tensione di soglia V_T . I segnali di ingresso $\Phi 1, \Phi 2, \Phi 3$ assumono i valori 0 e V_{dd} secondo l'andamento riportato in figura.

Si determini l'andamento qualitativo di segnali V_x e V_y e si dimensionino i MOS M2 e M3 in modo tale che con $\Phi1=V_{DD}, \Phi2=0$ e $\Phi3=V_{DD}, V_y$ sia pari a 0.5V e la potenza statica dissipata dall'intero circuito sia di 2mW





$$V_T = 0.6 \text{ V}, V_{dd} = 3.5 \text{ V}$$

Esame di ELETTRONICA AB (mod. B): svolgere gli esercizi 1 e 2.

Esame di ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI A: svolgere gli esercizi 3 e 4

Esame di FONDAMENTI DI ELETTRONICA A: svolgere almeno uno fra gli esercizi 1 e 2 e almeno uno fra gli esercizi 3 e 4.

- Indicare su ciascun foglio nome, cognome, data e numero di matricola
- Non usare penne o matite rosse
- L'elaborato deve essere contenuto in un unico foglio (4 facciate) protocollo

Esame scritto di Fondamenti di Elettronica A – 18.7.2006 - Esercizio #1

Osservazioni preliminari: il transistore Q quando ON è sempre in A.D. Inoltre fintantoché Q è ON, $vx=vu+v\gamma$, e vu>0 ($ie\neq 0$).

Regione 1: vi<vtn, allora M1 OFF. Q in AD (se vx> vg, da verificare).

Si rimane in regione 1 fintantochè M1 non va on, ovvero per vi>vtn.			
vx=vu+vγ (se Q1 on)	ie=vu/r3		
ir1=(vcc-vx)/r1	Ma $ie=(bf+1)*(ir1-ir2)$		
ir2=vx/r2	da cui si ricava che vu=3.224 V (e vx=3.974 V). OK Hp su Q.		

Regione 2: vi>vtn, quindi M1 ON e SAT se vu>vi-vtn-vγ (da vericare), e Q on in AD (sse vx>vγ,).

Cerco se in questa regione esistono punti della caratteristica statica di trasferimento a pendenza –1				
(cioè cerco i punti tali che dvu/dvi=-1).				
vx=vu+vγ (se Q1 on)	Ma			
ir1=(vcc-vx)/r1	ir1=idm1sat+ir2+ib			
ir2=vx/r2	d(ir1)/dvi=d(im1sat)/dvi+d(ir2)/dvi+d(ib)/dvi			
$ib=vu/r3/(\beta f+1)$				
$idm1sat=\beta_n/2*(vi-vtn)^2$	Risolvendo si ricava che vu=2.972 V, vi =1.004V.			
d(ir1)/dvi=1/r1	Tale coppia di valori soddisfa le HP fatte sulla regione di			
d(ir2)/dvi=-1/r2	funzionamento di M1 vu (= 2.972 V) > vi-vtn-v γ (= -0.246 V),			
$d(ib)/dvi=-1/r3/(\beta f+1)$	e di Q.			
$d(im1sat)/dvi=\beta_n/2*2*(vi-vtn)*1$	Quindi: V _{OHMIN} =2.972 V, V _{ILMAX} = 1.004 V.			

(eq.1)

Regione 3: vi>vtn, quindi M1 ON e LIN se vu<vi-vtn-vγ (da vericare), e Q on in AD (sse vx>vγ).

Cerco se in questa regione esistono punti della (cioè cerco i punti tali che dvu/dvi=-1).	caratteristica statica di trasferimento a pendenza -1
$\begin{array}{l} vx = vu + v\gamma \; (se \; Q1 \; on) \\ ir1 = (vcc - vx)/r1 \\ ir2 = vx/r2 \\ ib = vu/r3/(\beta f + 1) \\ idm1 lin = \beta_n*((vi - vtn)*(\; vu + v\gamma) - 1/2*(\; vu + v\gamma)^2) \\ d(ir1)/dvi = 1/r1 \\ d(ir2)/dvi = -1/r2 \\ d(ib)/dvi = -1/r3/(\beta f + 1) \\ d(im1 lin)/dvi = \beta_n*((vi - vtn)* - 1 + (vu + v\gamma) - 1/2*2*(vu + v\gamma)* - 1) \\ Ma \\ ir1 = idm1 lin + ir2 + ib \\ d(ir1)/dvi = d(im1 lin)/dvi + d(ir2)/dvi + d(ib)/dvi \\ \end{array}$	da cui si ricavano le seguenti coppie di valori (vi, vu): (vi=-2.315 V, vu=1.906 V) e (vi=2.307 V, vu=0.406 V). Delle due soluzioni quella accettabile è la seconda, quindi: V_{IHMIN} =2.307 V, e V_{OLMAX} =0.406 V. Tale coppia di valori soddisfa l'Hp su M1 lin, vu (=0.406) < vi-vtn-v γ (=1.057 V), e su Q. Si ricava allora che: NM_{H} =2.972 V-2.307 V= 0.665 V e NM_{L} =1.004 V-0.406 V = 0.598 V =NM

Regione 4: Per completezza: poi Q andrà off quando $vx=vu+v\gamma=v\gamma$, sse vu=0 V. Calcolo il valore di vi per il quale Q va off. M1 è lin.

$ir1=(vcc-(v\gamma))/r1$	Ma ir1=idm1lin+ir2, da cui si ricava che Q andrà
$ir2=(v\gamma)/r2$	OFF per:
idm1lin= β_n *((vi-vtn)*(v γ)-1/2*(v γ)^2)	vi= 3.042 V

Esame scritto di Fondamenti di Elettronica A – 18.7.2006 - Esercizio #2

OSS. PRELIMINARI:

- 1) M2 è ON quando vu<vdd-vt=3.0V, e quando ON è SAT (vdd-vu<vdd-vu+vt , 0<vt sempre).
- 2) M3 è ON quando vu>vt, e quando ON è SAT (vu<vu+vt, 0<vt sempre).

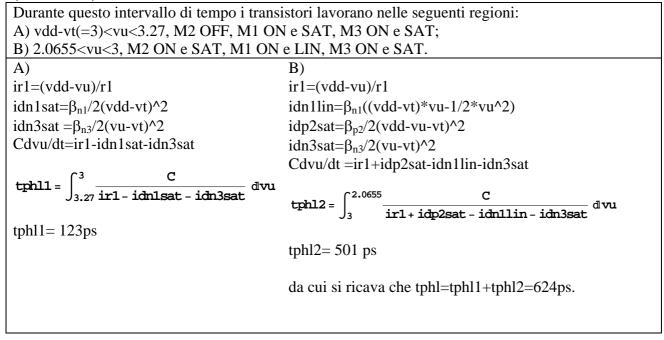
1) t<0, vi=0V, allora Mn1 OFF. Suppongo M2 OFF (sse vu>vdd-vt, da verificare),e Mn3 ON (sse vu>vt, da verificare) e SAT.

ir1=(vdd-vu)/r1	vu=-35.603 V o vu=3.27 V. Delle due
$idn3sat = \beta_{n3}/2*(vu-vt)^2$	soluzioni quella accettabile è vu=3.27 V.
Ma ir1 = idn3sat, da cui si ricava che:	Quindi M2 OFF (vu>3.0V), e M3 ON (vu>0.5V).

2) Per $t \to \infty$, vi=vdd, quindi M1 sarà ON e lo suppongo LIN (sse vu<vdd-vt, da verificare). M2 sarà ON e SAT(da verificare che vu<vdd-vt=3.0V) e Mn3 ON e SAT (sse vu>vt, da verificare).

$idn1lin = \beta_{n1}((vdd-vt)*vu-vu^2/2)$	da cui si ricava che : vu=0.861V o vu=6.460 V. Delle due
$idp2sat=\beta_{p2}/2(vdd-vu-vt)^2$	soluzioni quella accettabile è vu=0.861 V.
$idn3sat = \beta_{n3}/2(vu-vt)^2$	Quindi M1 ON e LIN (vu=(0.861V) < vdd-vt (=3.0V), e
ir1=(vdd-vu)/r1	M2 ON (vu=(0.861V) < vdd-vt (=3.0V V), e M3 ON
Ma ir1+idp2sat=idn1lin+idn3sat	(vu(=0.861V)>0.5V).

3) Il ritardo di propagazione è il tempo necessario al segnale d'uscita vu per compiere l'escursione da 3.27 --→ (3.27+0.861)/2=2.0655 V con vi=vdd.



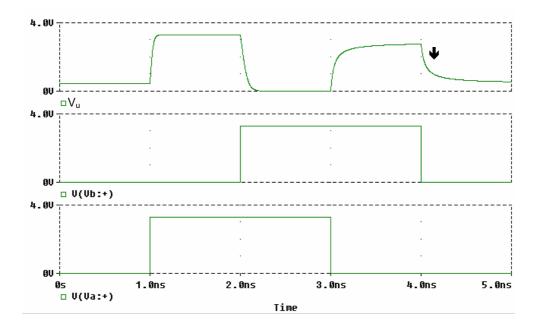
Esame scritto di Fondamenti di Elettronica A – 18.7.2006 - Esercizio #3

La risposta in condizioni statiche è descritta dalla tabella sottostante:

	V _a	V _b	V _u	M ₁	M ₂	M_3	M_4
(1)	0	0	V_{t}	OFF	ON	OFF	ON
(2)	0	V_{dd}	V_{dd} - V_t	OFF	ON	ON	OFF
(3)	V_{dd}	0	V_{dd}	ON	OFF	OFF	ON
(4)	V_{dd}	V_{dd}	0	ON	OFF	ON	OFF

Si tratta quindi di un XOR basato su pass-transistor; nella condizione (1) il valore di uscita basso è "debole", poiché il nodo si scarica attraverso il pMOS M₄, mentre nella condizione (2) il valore di uscita alto è "debole", poiché il nodo si carica attraverso l'nMOS M₃ in serie al pMOS M₂.

L'andamento qualitativo dell'uscita è quindi il seguente:



A seguito della transizione evidenziata, il condensatore di uscita, inizialmente carico a V_{dd} - V_t , si scarica al valore V_t attraverso il pMOS M4. Tale transistore è sempre in saturazione ($V_{sg}=V_{sd}=V_u$), per cui il tempo di propagazione, necessario a compiere metà dell'escursione (V_u : $V_{dd}-V_t \rightarrow V_{dd}/2$) si calcola tramite l'integrale:

$$t_p = \int_{\text{Voll-Vt}}^{\text{Volly2}} \frac{-2C}{B_p(\text{Vu-Vt})^2} dV \text{u}$$

la cui soluzione vale circa 41 ps.

Esame scritto di Fondamenti di Elettronica A - 18.7.2006 - Esercizio #4

Soluzione